



ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС

Высокая стойкость к
электротермоциклированию
Низкие статические и динамические потери
Разработан для промышленного
применения

Полупроводниковый Элемент Низкочастотного Диода Тип DR80-3200-36

Максимально допустимый средний прямой ток ¹⁾			I _{FAV}	3200 A
Повторяющееся импульсное обратное напряжение			U _{RRM}	3000...3600 В
U _{RRM} , В	3000	3200	3400	3600
Класс по напряжению	30	32	34	36
T _я , °C	-60...+160			

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

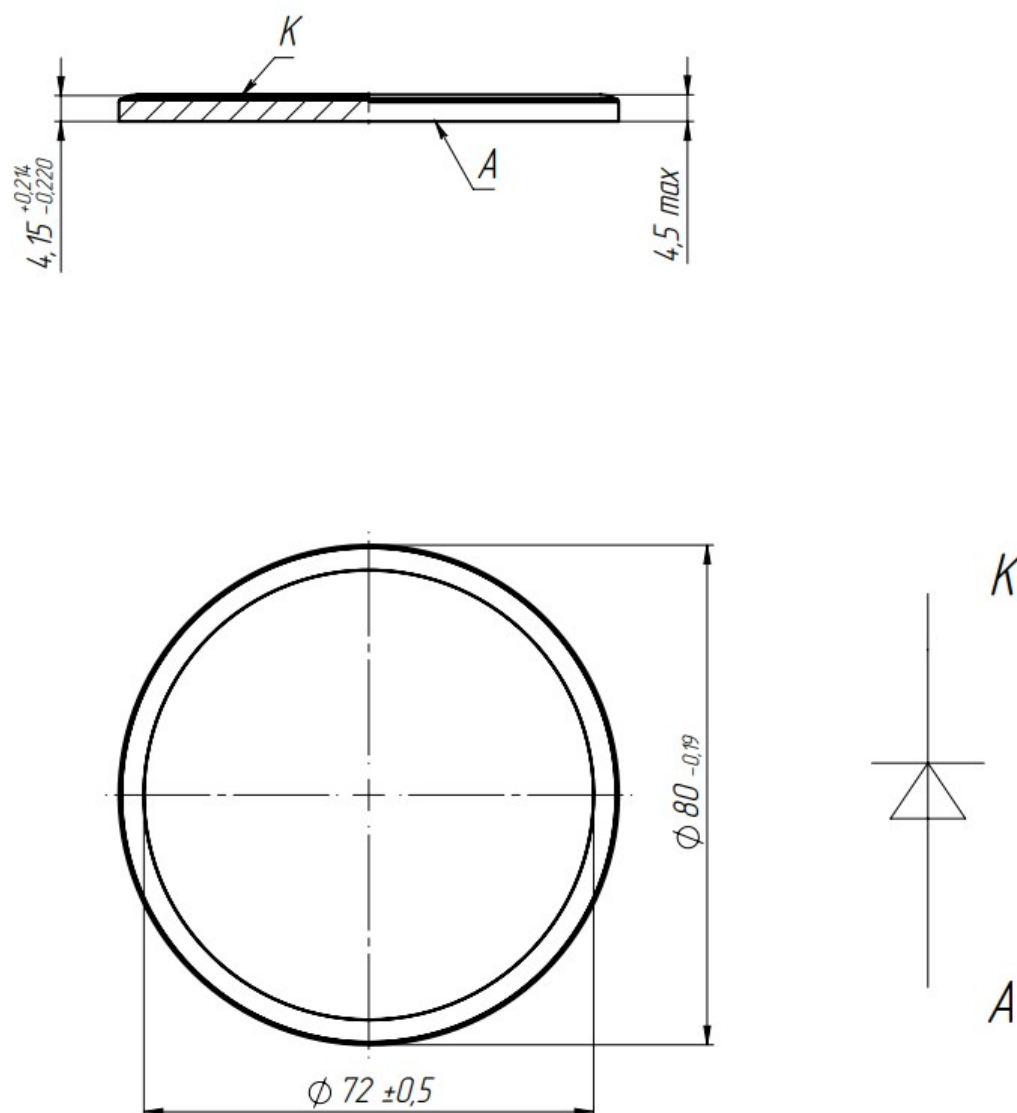
Обозначение и наименование параметра		Ед. изм.	Значение	Условия измерения	
Параметры в проводящем состоянии					
I _{FAV}	Максимально допустимый средний прямой ток ¹⁾	A	3200 3853	T _c =114 °C; двухстороннее охлаждение; T _c =100 °C; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I _{FRMS}	Действующий прямой ток ¹⁾	A	5024	T _c =114 °C; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I _{FSM}	Ударный ток ¹⁾	кА	58.0 70.0	T _j =T _{j max} T _j =25 °C	180 эл. град. синус; t _p =10 мс; единичный импульс; U _R =0 В;
			61.0 73.0	T _j =T _{j max} T _j =25 °C	180 эл. град. синус; t _p =8.3 мс; единичный импульс; U _R =0 В;
I ² t	Защитный показатель ¹⁾	A ² с·10 ³	16800 24500	T _j =T _{j max} T _j =25 °C	180 эл. град. синус; t _p =10 мс; единичный импульс; U _R =0 В;
			15400 22100	T _j =T _{j max} T _j =25 °C	180 эл. град. синус; t _p =8.3 мс; единичный импульс; U _R =0 В;
Блокирующие параметры					
U _{RRM}	Повторяющееся импульсное обратное напряжение	В	3000...3600	T _{j min} < T _j < T _{j max} ; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
U _{RSM}	Неповторяющееся импульсное обратное напряжение	В	3100...3700	T _{j min} < T _j < T _{j max} ; 180 эл. град. синус; единичный импульс	
U _R	Постоянное обратное напряжение	В	0.6·U _{RRM}	T _j =T _{j max}	
Тепловые параметры					
T _{stg}	Температура хранения	°C	−60...+50		
T _j	Температура р-п перехода	°C	−60...+160		
Механические параметры					
F	Монтажное усилие ¹⁾	кН	40...50		

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение и наименование характеристики		Ед. изм.	Значение	Условия измерения	
Характеристики в проводящем состоянии					
U _{FM}	Импульсное прямое напряжение ¹⁾ , макс	В	1.80	T _j =25 °C; I _{FM} =10048 А	
U _{F(TO)}	Пороговое напряжение, макс	В	0.878	T _j =T _{j max} ; 0.5 π I _{FAV} < I _T < 1.5 π I _{FAV}	
r _T	Динамическое сопротивление ¹⁾ , макс	МОм	0.101		
Блокирующие характеристики					
I _{RRM}	Повторяющийся импульсный обратный ток, макс	мА	150	T _j =T _{j max} ; U _R =U _{RRM}	
Тепловые характеристики					
R _{thjc}	Тепловое сопротивление р-п переход-корпус ¹⁾ , макс	°C/Вт	0.0085	Постоянный ток	Двухстороннее охлаждение
R _{thjc-A}			0.0187		Охлаждение со стороны анода
R _{thjc-K}			0.0153		Охлаждение со стороны катода
Механические характеристики					
m	Масса, макс	г	201		

МАРКИРОВКА		ПРИМЕЧАНИЕ
DR 80 3200 36 1 2 3 4 1. ППЭ Низкочастотного Диода 2. Максимальный диаметр, мм 3. Средний прямой ток, А 4. Класс по напряжению		¹⁾ В зависимости от характеристик применяемого корпуса. Указанные значения актуальны при использовании корпуса Протон-Электротекс D.F3.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Все размеры в миллиметрах

Содержащаяся здесь информация является конфиденциальной и находится под защитой авторских прав.
В интересах улучшения качества продукции, АО «Протон-Электротекс» оставляет за собой право изменять информационные листы без уведомления.